

I. ポスター展示リスト【企業】

No.	企業名	担当者氏名
1.	三菱ケミカル株式会社	磯 憲司
2.	ウシオ電機株式会社	深町 俊彦
3.	株式会社イオンテクノセンター	須山 篤志
4.	サムコ株式会社	土橋 篤志
5.	サンケン電気株式会社	八木 修一
6.	株式会社堀場エステック	佐藤 陽子
7.	レーザーテック株式会社	藤木 翔太
8.	株式会社レーザーシステム	大野 泰夫
9.	株式会社SCREENセミコンダクタソリューションズ	谷出 敦
10.	株式会社シルバコ・ジャパン	大田 一樹

II. ポスター展示リスト【学生】

No.	「タイトル」 発表者（所属）
1.	「HVPE法によるCr ₂ O ₃ テンプレート上へのGa ₂ O ₃ 成長」 武田 葉太 ¹ , 森下 優 ¹ , 肖 世玉 ² , 村上 和仁 ² , 渡邊 守道 ² , 富田 崇弘 ² , 宮川 鈴衣奈 ^{1,3} (1.名古屋工業大学 2.日本ガイシ株式会社 3.核融合科学研究所)
2.	「フェムト秒レーザーによる核融合炉応用のためのタンゲステン表面加工」 古川 剛 ¹ , 稲垣 達貴 ¹ , 上原 日和 ^{2,3} , 宮川 鈴衣奈 ^{1,2} (1.名古屋工業大学 2.核融合科学研究所 3.総合研究大学院大学)
3.	「Extremely small trap concentrations in quartz-free hydride vapor phase epitaxy-grown n-type GaN confirmed by capacitance transient spectroscopy」 平山 祐輔（名古屋大学 須田研究室）
4.	「Unified explanation of bias dependence of threshold voltage shift under positive bias stress in GaN planer MOSFETs with SiO ₂ gate dielectric」 市川 雄基（名古屋大学 須田研究室）
5.	「Analysis of Acceptor Activation and Lateral Diffusion of Channeled-implanted Mg Atoms in Vertical GaN Junction Barrier Schottky Diodes」 北川 和輝（名古屋大学 須田研究室）
6.	「薄膜ベース p-GaNを用いた AlGaN/GaN HBTの作製」 丸繁 太一（名古屋大学 天野・本田研究室）
7.	「AlGaN/GaNヘテロ構造におけるIn組成とAIN中間層が2DEG特性へ与える影響」 脇迫 謙（名古屋大学 天野・本田研究室）
8.	「Design Guideline of Compensation Networks in Capacitive Power Transfer System for EVs」 山中 夕雅（名古屋大学 山本研究室）
9.	「Power Module Design to Reduce Common-Mode Noise」 野崎 凌汰（名古屋大学 山本研究室）